

Тематический указатель статей, опубликованных в 2012 году

Фундаментальные исследования

Бормонтов Е.Н., Ганин А.А., Битюцкая Л.А. Осцилляции ширины запрещенной зоны одностенных углеродных нанотрубок в области сверхмалых диаметров. № 2(94), с. 10.

Воронин И.В., Горбатов С.А., Дьяконова О.А., Науменко В.Ю. Особенности взаимодействия кольцевых киральных сред с электромагнитным излучением сантиметрового и дециметрового диапазонов. № 3(95), с. 11.

Лавров И.В. Эффективная проводимость поликристаллической среды в случае слабой макроскопической анизотропии. № 4(96), с. 3.

Морозова Н.К., Галстян В.Г., Олешко В.И., Данилевич Н.Д., Вильчинская С.С. Экситонные полосы CdO в спектрах кристаллов CdS(O). № 6(98), с. 3.

Морозова Н.К., Данилевич Н.Д., Олешко В.И., Вильчинская С.С. Особенности экситонных спектров монокристаллов. CdS(O). № 1(93), с. 14.

Морозова Н.К., Данилевич Н.Д., Олешко В.И., Вильчинская С.С. Три типа центров самоактивированного свечения CdS(O). № 3(95), с. 3.

Попков А.Ф., Соловьев С.В., Кулагин Н.Е., Звездин А.К. Пространственно-модулированные антиферромагнитные структуры в мультиферроике с двуслойной анизотропией. № 2(94), с. 3.

Чумаков А.И., Афонин А.В., Полушин В.А. Особенности энерговыделения в микрообъемах элементов СБИС при воздействии нейтронного излучения. № 5(97), с. 5.

Яременко Н.Г., Карачевцева М.В., Страхов В.А. Фотолюминесцентная спектроскопия односторонне легированных структур n -AlGaAs/GaAs с квантовыми ямами. № 1(93), с. 3.

Материалы электронной техники

Белов А.Н., Волосова Ю.В., Гаврилов С.А. Влияние геометрических параметров пористых слоев оксида алюминия на характеристики влагочувствительной структуры на его основе. № 1(93), с. 21.

Грибов Б.Г., Зиновьев К.В., Калашник О.Н., Герасименко Н.Н., Смирнов Д.И., Суханов В.Н. Выращивание нанокристаллического кремния из матрицы аморфного монооксида кремния. № 4(96), с. 13.

Громов Д.Г., Козьмин А.М., Шулятьев А.С., Поломоинов С.А., Шаманаев С.В., Боголюбова Д.Н. Влияние условий формирования на свойства тонких пленок ZnO:Ga, осажденных методом магнетронного распыления на холодную подложку. № 6(98), с. 10.

Кулеманов И.В., Тарелкин С.А. Прыжковый транспорт носителей в эпитаксиальных слоях V:TiO_{2-x}. № 2(94), с. 15.

Тарасов С.А., Грачева И.Е., Гареев К.Г., Гордюшенков О.Е., Ламкин И.А., Менькович Е.А., Мошников В.А., Преснякова А.В. Атомно-силовая микроскопия и фотолюминесцентный анализ пористых материалов на основе оксидов металлов. № 2(94), с. 21.

Микроэлектронные приборы и системы

Бороздина А.Б., Чумаков А.И., Уланова А.В., Никифоров А.Ю., Петров А.Г. Выявление многократных сбоев в микросхемах СОЗУ от воздействия отдельных заряженных частиц космического пространства. № 5(97), с. 44.

Васильев Е.С. Методика расчета параметров усилителей считывания для ЭСППЗУ и флэш-памяти. № 4(96), с. 32.

- Васильев Е.С.** Оптимизация архитектуры устройства с зарядовой накачкой по критерию занимаемой площади. № 6(98), с. 36.
- Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И.** Влияние конструктивных параметров и управляющих напряжений на фотоэлектрические характеристики фотоячейки с тремя вертикально интегрированными $p-n$ -переходами. № 4(96), с. 18.
- Дмитриев А.Н., Чередниченко Д.И.** Модель вакуумного микротриода с автокатодом на основе графитизированной поверхности карбида кремния. № 2(94), с. 35.
- Елесин В.В., Назарова Г.Н., Усачев Н.А., Чуков Г.В., Сотсков Д.И., Репин В.В., Мухин И.И.** Построение монолитных ИС многоразрядных фазовращателей СВЧ-диапазона с улучшенными точностными характеристиками. № 5(97), с. 31.
- Елесин В.В., Назарова Г.Н., Чуков Г.В.** Расчетно-экспериментальное моделирование СВЧ-характеристик металлокерамических и металлоглазанных корпусов ИС. № 5(97), с. 24.
- Козлов А.В., Королёв М.А., Жуков А.А., Тихонов Р.Д., Черемисинов А.А.** Влияние конструктивно-технологических параметров на характеристики трехколлекторного биполярного магнитотранзистора. № 6(98), с. 43.
- Лугин А.Н.** Теория электрических контактов в аспекте электропроводности резистивных пленок. № 3(95), с. 33.
- Лугин А.Н., Оземша М.М.** Об ограничении значений допускаемого отклонения и стабильности сопротивления тонкопленочных чип-резисторов. № 1(93), с. 32.
- Лычагин Е.В., Новиков С.Г., Гурин Н.Т.** Пороговый позиционно-чувствительный фотопереключателъ с отрицательным дифференциальным сопротивлением. № 1(93), с. 26.
- Макаров А.Б.** КМОП-операционный усилитель с n -канальными выходными повторителями, увеличенным коэффициентом усиления и малым временем установления. № 4(96), с. 24.
- Никифоров А.Ю., Скоробогатов П.К., Стриханов М.Н., Телец В.А., Чумаков А.И.** Развитие базовой технологии прогнозирования, оценки и контроля радиационной стойкости изделий микроэлектроники. № 5(97), с. 18.
- Разживалов П.Н., Блинов В.Д.** Влияние тепловых воздействий на погрешность приборов астроориентации. № 1(93), с. 38.
- Рындин Е.А., Денисенко М.А.** Модель функционально-интегрированных инжекционных лазеров-модуляторов для интегральных систем оптической коммутации. № 6(98), с. 26.
- Скоробогатов П.К.** Лазерное имитационное моделирование объемных ионизационных эффектов в субмикронных СБИС. № 5(97), с. 39.
- Шемякин А.В.** Методика расчета конструктивно-технологических параметров мощного СВЧ LDMOS-транзистора. № 3(95), с. 26.

Нанотехнология

- Агеев О.А., Смирнов В.А., Солодовник М.С., Рукомойкин А.В., Авилов В.И.** Исследование режимов формирования оксидных наноразмерных структур арсенида галлия методом локального анодного окисления. № 2(94), с. 43.
- Басаев А.С.** Влияние концентрации ферроцена в рабочей газовой смеси на параметры роста углеродных нанотрубок. № 2(94), с. 51.

Схемотехника и проектирование

- Беспалов В.А., Овчинников В.А., Сидоренко Н.И., Базанов Д.В., Беленков А.Н., Дорл В., Штольберг И.** Опыт изготовления прецизионных фотошаблонов с применением высокоточных генераторов изображения. № 2(94), с. 55.
- Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Стемпковский А.Л.** Анализ быстродействия нанометровых сложнофункциональных блоков на основе интервального моделирования. № 4(96), с. 40.
- Егоров А.Н., Телец В.А., Чумаков А.И., Маврицкий О.Б., Печенкин А.А., Яненко А.В.,**

Кольцов Д.О. Моделирование эффектов воздействия отдельных заряженных частиц космического пространства на изделия микроэлектроники и твердотельной СВЧ-электроники с использованием пикосекундного лазера. № 5(97), с. 60.

Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Никифоров А.Ю. Модель реакции импульсных стабилизаторов напряжения при воздействии космических радиационных факторов. № 5(97), с. 55.

Мухин И.И., Репин В.В. Проектирование полупроводниковых БИС активных фазовращателей с использованием SiGe-БиКМОП-технологии. № 4(96), с. 54.

Романюк В.А., Аунг Бо Бо Хэйн. Проектирование схем активных смесителей СВЧ для обеспечения максимума усиления преобразования. № 4(96), с. 60.

Стенин В.Я. Моделирование пороговых параметров, ограничивающих сбоеустойчивость 45- и 65-нм двухфазных КМОП-инверторов при воздействии отдельных ядерных частиц. № 5(97), с. 49.

Эннс А.В., Эннс В.И. Метод построения и анализа высокочастотных импульсных источников питания. № 4(96), с. 50.

Микропроцессорная техника

Беляев А.А. Реализация SIMD-распараллеливания в сигнальных процессорах платформы «Мультикор». № 2(94), с. 67.

Вакуумная электроника

Ли И.П., Петров В.С., Васильевский В.В., Гайдар А.И., Прокофьева Т.В. Исследование процесса активации прессованного палладий-бариевого катода магнетрона с безнакальным запуском. № 6(98), с. 17.

Информационные технологии

Акинишин Р.Н., Сигитов В.В., Минаков Е.И., Морозов Д.В. Математическая модель системы отображения информации тренажера с распределенной обработкой данных. № 3(95), с. 47.

Алексеев В.Е., Крыликов Н.О., Соловьев А.Н. Сравнение эффективности применения многоантенных навигационных систем GPS и совмещенной ГЛОНАСС/GPS. № 2(94), с. 71.

Крыликов Н.О. Алгоритмическое обеспечение вычислительных систем комплексов ближней радиолокации. № 4(96), с. 80.

Лупин С.А., Тхан Зо У, Чжо Мью Хтун. Применение алгоритмов случайного поиска для решения задачи диспетчеризации в распределенных системах обслуживания. № 3(95), с. 40.

Михайлов И.И. Оценка качества обработки изображения линейного многоширинного штрихового кода на этапах демодуляции. № 1(93), с. 67.

Ожегин Ю.А., Уваркин Д.С. Информационные технологии мониторинга радиационных испытаний электронной компонентной базы. № 5(97), с. 67.

Туркин А.В. Выделение локальных особенностей бинарного изображения отпечатка пальца. № 1(93), с. 59.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Воробьев Н.В., Петров О.В. Многофункциональный характериограф для экспресс-анализа радиоэлектронной аппаратуры. № 1(93), с. 72.

Захаров В.Д., Лепёхина Т.А., Николаев В.И., Титов М.П., Толстов Е.Ф., Четверик В.Н. Проблемы оценки пространственного и радиометрического разрешения РСА. № 6(98), с. 65.

Суханов Е.С., Лялин К.С. Сравнительный анализ методов подавления боковых лепестков автокорреляционной функции в метеорадиолокации. № 3(95), с. 58.

Широ Г.Э., Широ Е.Г. Метод снижения влияния боковых лепестков шумоподобных сигналов в радиолокационных системах с синтезированием апертуры антенны. № 1(93), с. 79.

Методы и техника измерений

- Алексеев Ю.И., Орда-Жигулина М.В., Ле Тхай Шон.* Детектирование СВЧ-модулированных оптических сигналов с помощью полупроводникового лазера. № 3(95), с. 75.
- Ахметов А.О., Бобровский Д.В., Калашиников О.А., Некрасов П.В., Тарараксин А.С., Яненко А.В.* Диагностика независимых событий одиночных сбоев и тиристорных эффектов при испытаниях цифровых КМОП ИС. № 5(97), с. 85.
- Бобровский Д.В., Давыдов Г.Г., Петров А.Г., Яненко А.В., Ахметов А.О., Боруздина А.Б., Калашиников О.А., Кессаринский Л.Н., Некрасов П.В., Никифоров А.Ю., Уланова А.В.* Реализация базовых методов радиационных испытаний ЭКБ на основе аппаратно-программного комплекса аппаратуры National Instruments. № 5(97), с. 91.
- Виноградов А.И., Зарянкин Н.М., Тимошенко С.П.* Зондовые исследования характеристик плазмы в реакторе ИСР-типа. № 1(93), с. 54.
- Литманович Д.М., Литманович А.М., Тихонов К.С.* Определение координат объекта по теневым составляющим для устройства пространственной ориентации на базе многослойных конформных коммутационных плат. № 6(98), с. 73.
- Печерская Е.А., Соловьев В.А., Метальников А.М., Бобошко А.В.* Методы исследования температурных зависимостей диэлектрических параметров сегнетоэлектриков. № 2(94), с. 77.
- Савченков Д.В., Печенкин А.А.* Влияние конечного размера пятна лазерного облучения на достоверность оценки сечений одиночных эффектов. № 5(97), с. 71.
- Сергеев В.А., Смирнов В.И., Гавриков А.А., Фролов И.В.* Измерение теплового импеданса мощных светодиодов с применением широтно-импульсной модуляции мощности. № 3(95), с. 64.
- Тарараксин А.С., Яненко А.В., Чумаков А.И.* Рациональный состав испытаний электронной компонентной базы на стойкость к воздействию отдельных ядерных частиц. № 5(97), с. 78.
- Терещенко С.А., Титенок С.А., Долгушин С.А.* Применение метода Монте-Карло для определения точности диффузионных моделей прохождения оптического излучения через однородный рассеивающий слой. № 3(95), с. 69.
- Филиппов В.В., Власов А.Н.* Зондовые измерения распределения потенциала в анизотропных полупроводниковых кристаллах и пленках. № 1(93), с. 48.

Микро- и наносистемная техника

- Амеличев В.В., Сауров А.Н., Аравин В.В., Резнев А.А., Демин А.А., Хохлов М.В.* Беспроводная магниторезистивная микросистема измерения магнитного поля. № 6(98), с. 57.
- Амеличев В.В., Годовицын И.В., Ильков А.В., Костромин А.Ю.* Моделирование микродвигателя на основе КНИ-структуры. № 1(93), с. 43.
- Бедная Т.А., Коноваленко С.П., Семенистая Т.В., Петров В.В., Королев А.Н.* Газочувствительные элементы сенсора диоксида азота и хлора на основе кобальтсодержащего полиакрилонитрила. № 4(96), с. 66.
- Гридчин В.А., Чебанов М.А., Васильев В.Ю.* Моделирование влияния конструктивно-технологических параметров на характеристики кремниевых резонансных сенсоров давления. № 2(94), с. 61.
- Соловьев А.Н., Алексеев В.Е., Саблин А.В.* Построение навигационной инерциальной системы на основе распределенного множества полупроводниковых акселерометров. № 4(96), с. 72.
- Тимошенко С.П., Кульчицкий А.П.* Применение МЭМС-сенсоров в системах навигации и ориентации подвижных объектов. № 6(98), с. 51.

Технология микро- и нанoeлектроники

- Бобринецкий И.И., Неволин В.К., Ромашкин А.В.* Квазиодномерные молекулярные транзисторы на основе полианилина и углеродных нанотрубок в качестве электродов. № 2(94), с. 27.

Ли И.П., Поляков В.С., Силаев А.Д., Харитонова Н.Е., Петров В.С. Анализ современных представлений о синтезе наноразмерных эмиссионных гетероструктур на поверхности палладий-бариевого катода при активировании. № 3(95), с. 19.

Яшанин И.Б., Давыдов Г.Г., Никифоров А.Ю., Московская Ю.М. Влияние нестабильности параметров технологического процесса изготовления КНД ИС на их радиационное поведение. № 5(97), с. 11.

Краткие сообщения

Александров А.А., Умняшкин С.В. Модификация алгоритма кодирования разностного кадра для видеокodeка на базе дискретного вейвлет-преобразования. № 6(98), с. 92.

Бойко А.Н., Тимошенко С.П., Гаев Д.С., Хаубольд М., Вимер М., Гесснер Т. Оценка параметров герметичности корпусированных микроструктур. № 3(95), с. 87.

Вяткин А.Ф., Зиненко В.И. Послойный анализ металлизации современных интегральных схем с помощью физического ионного распыления. № 2(94), с. 95.

Герасимчук О.А., Скоробогатов П.К. Электротепловое моделирование влияния одиночных импульсов напряжения на КМОП ИС различных технологий. № 5(97), с. 105.

Гончаров В.А., Зиновьев Д.В., Локтев Д.В. Исследование теплопроводности разреженных газов в условиях высокоградиентного температурного поля. № 6(98), с. 83.

Городилов А.В., Кононова А.И., Шаньгин В.Ф. Особенности передачи данных в децентрализованных пиринговых сетях. № 6(98), с. 95.

Громов Д.Г., Козьмин А.М., Шулятьев А.С., Поломошнов С.А., Шаманаев С.В. Технология формирования пленок ZnO:Ga для создания преобразователей акустического давления. № 2(94), с. 92.

Гуреев А.В., Тай Зар Линн. Влияние интерференционных замираний на характеристики передачи информации в гористой местности. № 6(98), с. 90.

Захаров В.Д. Оценка радиометрических характеристик радиолокационных изображений в РСА после вторичной обработки с использованием метода дифференциального радиоконтраста. № 2(94), с. 97.

Козлов А.В., Королёв М.А., Поломошнов С.А., Тихонов Р.Д., Черемисинов А.А., Шаманаев С.В. Приборно-технологическое моделирование чувствительности биполярных магнитотранзисторов для прецизионного контроля перемещений микромеханических элементов. № 2(94), с. 90.

Кондрашов В.А., Неволин В.К. Влияние материала зонда на локальное анодное окисление подложек. № 6(98), с. 80.

Крыликов Н.О., Плавич М.Л. Разработка многоканального высокочастотного программно-перестраиваемого генератора псевдослучайной последовательности. № 3(95), с. 83.

Ламзин В. А., Сергеев В. А., Юдин В. В. Зависимость температурного коэффициента напряжения логической единицы КМОП цифровых интегральных микросхем от тока нагрузки. № 6(98), с. 87.

Лобанова А.Ю. Выбор методов уменьшения рассеиваемой мощности при проектировании блоков высокопроизводительных микропроцессоров. № 3(95), с. 81.

Макан И.И., Шелехов Р.В., Шахворостов Д.Ю. Особенности настройки чувствительного элемента балочного пьезокерамического биморфного датчика угловых скоростей. № 3(95), с. 84.

Маслобоев Ю.П., Потапов Д.А. Метод расчета временного распределения ультракороткого лазерного импульса, прошедшего через неоднородную рассеивающую среду. № 1(93), с. 91.

Соколов Е.Б., Рыгалин Б.Н., Прокофьева В.К., Яремчук А.Ф. Влияние геттерирования расплава на рекомбинационные характеристики кремния для ФЭП. № 6(98), с. 78.

Селецкий А.В., Шелепин Н.А. Исследование возможности формирования охранных областей *r*-типа легированием примеси индия с помощью средств приборно-технологического моделирования. № 6(98), с. 85.

Терещенко С.А., Антаков М.А. Учет преломления света в методе ро-фильтрации томографической реконструкции поглощающих объектов. № 4(96), с. 93.

Терещенко С.А., Титенок С.А. Диффузионная модель переноса излучения в слаборассеивающих средах. № 1(93), с. 93.

Тимошенко С.П., Шалимов А.С., Кочурина Е.С., Наинг С.М., Бушак А.Р. Исследование статических характеристик емкостного преобразователя линейного ускорения на базе микросхемы отечественного производства. № 4(96), с. 90.

Топильский В.Б., Бажанов Е.И. Оценка погрешности дифференциального емкостного датчика перемещений. № 4(96), с. 88.

Щагин А.В., Бирюков М.Ю., Шедяков Д.Ю. Микропроцессорное устройство управления асинхронным двигателем на базе программно-регулируемых IGBT-модулей. № 4(96), с. 86.

Юбилей

Вернеру Виталию Дмитриевичу – 80 лет. № 1(93), с. 95.

Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ» 70 лет. № 5(97), с. 3

Конференции. Школы

3-я Международная научно-техническая конференция «Технологии микро- и нанoeлектроники в микро- и наносистемной технике» (28–29 ноября 2012 г., Зеленоград). № 5(97), 4 стр. обложки.

5-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информатизации в науке, образовании и экономике – 2012» № 4(96), 2 стр. обложки.

8 февраля – День российской науки. Мизтовские научные чтения. № 1(94), 2 стр. обложки.

20-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2013». №6 (98), 2 стр. обложки.

Всероссийская мультikonференция «Актуальные проблемы радиоэлектроники, информационных и нанотехнологий» (г. Таганрог, Ростовская область, Россия). № 2(94), с. 100.

Об итогах 4-й Международной конференции «Химия нанотрубок и графена» (1–5 апреля 2012 г., г. Аркашон, Франция). № 3(95), с. 90.

Об итогах работы VII Международной научно-технической конференции «Информационные технологии в науке, технике и образовании» (Республика Абхазия, Кодори). № 1(93), с. 97.

VIII Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании» (Республика Абхазия, Пицунда, 17–29 сентября 2012 г.). № 3(95), с. 92.

Московско-Баварская студенческая школа MB-JASS. № 3(95), с. 91.

Проблемы высшего образования

Колдаев В.Д. Кредитно-модульная система организации учебного процесса при моделировании индивидуальных образовательных траекторий. № 2(93), с. 82.

Колдаев В.Д. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий с использованием диаграмм связей. № 1(93), с. 84.